

附件一

电子元器件自查承诺书

依据 ZKB 3101-001-2022《军用电子元器件自主可控评估通用准则》和 ZKB 3101-002-2024《武器装备使用国产电子元器件“伪、空、包”产品判定准则(试行)》的相关要求，我单位针对研制生产的电子元器件产品开展自主可控等级和“伪、空、包”情况自查及评估。结果如下：

自查产品共8项，其中自主可控 A 级0项、B 级8项、C 级0项、C*级0项、D 级0项、E 级0项；伪国产化0项、包装国产化0项、空心国产化0项。

电子元器件“伪、空、包”审查基本信息填写表详见附表一；电子元器件使用 IP 核情况、原材料和零部件、工艺流片等基本情况填写表详见附表二。

我单位承诺以上内容真实有效，自愿承担一切后果。

特此承诺。



附表一

电子元器件“伪、空、包”审查信息一览表

序号	元器件名称 ^a	型号规格 ^b	生产厂商 ^c	自主可控等级 ^d	是否“伪国产化” ^e		是否“包装国产化” ^e		是否“空心国产化” ^e		备注 ^e
					是/否	情况说明	是/否	情况说明	是/否	情况说明	
1	MCU	JTLX32F103TBU	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
2	MCU	JTLX32F103TBU(W)	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
3	MCU	TLX32F103TBU6	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
4	MCU	JTLX32F103CBT	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
5	MCU	JTLX32F103CBT(W)	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
6	MCU	TLX32F103CBT6	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
7	MCU	JTLX32F103RBT	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
8	MCU	JTLX32F103RBT(W)	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
9	MCU	TLX32F103RBT6	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	

填表说明：

^a. 应是元器件全称，与详细规范或产品技术资料上的名称相符；

填报单位（盖章）：

法定代表人（签章）：

填表人（签字）

电话：

填报日期：20250520



汤黎明

姜春雷

18221090182

- ^b. 应填写元器件完整型号规格；
- ^c. 应填写元器件生产厂商中文全称，勿填写代理商；
- ^d. 按照 ZKB 3101-001-2022 《军用电子元器件自主可控评估通用准则》执行，分为 A、B、C、C*、D、E 六个等级，针对为军选民用计算机设备等配套的中央处理器、图形处理器、网络交换芯片、网络处理器芯片、网络控制器芯片、存储控制器芯片按照 GJB 9530 执行；
- ^e. “伪、空、包”应按照 ZKB3101-002-2022 标准执行。若为“是”时，则需要在“情况说明”写明判别因素；若为“否”时，则填“无”；
- ^f. 若存在其他需要说明的情况，可在备注栏填写。



填报单位（盖章）：

法定代表人（签章）：

填表人（签字）

电话：

填报日期：20250520

汤翠珂

姜春雷

18221090182

附表二

电子元器件基本信息表

序号	元器件名称 ^a	型号规格 ^b	使用 IP 核情况 ^c				原材料和零部件 ^d				流片工艺 ^e		备注
			名称	类型	来源单位	境内/境外	名称	是否“核心”/“关键” ^e	来源单位 ^f	境内/境外	工艺名称	境内/境外	
1	MCU	JTLX32F103TBU	IP 核 1	硬核	杭州朔天	境内	流片	关键	和舰科技	境内	110nm eflash	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
2	MCU	JTLX32F103TBU (W)	IP 核 1	硬核	杭州朔天	境内	流片	关键	和舰科技	境内	110nm eflash	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
3	MCU	TLX32F103TBU6	IP 核 1	硬核	杭州朔天	境内	流片	关键	和舰科技	境内	110nm eflash	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
4	MCU	JTLX32F103CBT	IP 核 1	硬核	杭州朔天	境内	流片	关键	和舰科技	境内	110nm eflash	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
5	MCU	JTLX32F103CBT (W)	IP 核 1	硬核	杭州朔天	境内	流片	关键	和舰科技	境内	110nm eflash	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
6	MCU	TLX32F103CBT	IP 核 1	硬核	杭州朔天	境内	流片	关键	和舰科技	境内	110nm eflash	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
7	MCU	JTLX32F103RBT	IP 核 1	硬核	杭州朔天	境内	流片	关键	和舰科技	境内	110nm eflash	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				

填报单位（盖章）：

法定代表人（签章）：

填报人（签字）

电话：

填报日期：20250520

8	MCU	JTLX32F103RBT (W)	IP 核 1	硬核	杭州朔天	境内	流片	关键	和舰科技	境内	110nm eflash	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
9	MCU	TLX32F103RBT6	IP 核 1	硬核	杭州朔天	境内	流片	关键	和舰科技	境内	110nm eflash	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				

填表说明：

- ^a. 应是元器件全称，与详细规范或产品技术资料上的名称相符；
- ^b. 应填写元器件完整型号规格；
- ^c. 仅适用于半导体集成电路，应填写 IP 核类型，包括“软核”“固核”“硬核”；
- ^d. 本表中应填报的原材料和零部件应根据实际情况填写，至少包含 ZKB 3101-002-2022 标准附录 A 中内部零部件或原材料，同时也应包含外壳、引出端、键合丝等，不包含灌封料等生产过程材料；
- ^e. 应根据 ZKB 3101-002-2022 标准附录 A 填写“核心”或“关键”，非“核心”或“关键”原材料和零部件此项不填；
- ^f. 应根据实际设计单位或生产商情况填写，不能按代理商填写；对来源不明的，应填写“来源不明”，具体判定时视为“境外”；
- ^g. 仅适用于半导体集成电路，应填写流片工艺名称，如 45nmBCD 工艺等，必要时在备注中填写流片厂商信息。



填报单位（盖章）：

法定代表人（签章）：

汤翠明

填表人（签字）

姜春雷

电话：

18221090182

填报日期：20250520